(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2010 年 3 月 11 日(11.03.2010)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2010/026893 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/683 (2006.01) *B23Q 3/15* (2006.01)
H02N 13/00 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2009/064831

(22) 国際出願日: 2009 年 8 月 26 日(26.08.2009)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2008-226664 2008 年 9 月 4 日(04.09.2008) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社クリエイティブ テクノロジー(CREATIVE TECHNOLOGY CORPORATION) [JP/JP]; 〒1020083 東京都千代田区麹町１－８－１４麹町ＹＫビル５Ｆ Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 藤澤 博 (FUJISAWA Hiroshi) [JP/JP]; 〒6308301 奈良県奈良市高畑町５３７－７ Nara (JP).

(74) 代理人: 佐々木 一也, 外(SASAKI Kazuya et al.); 〒1050003 東京都港区西新橋２丁目１１番５号 ＴＫＫ西新橋ビル５階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

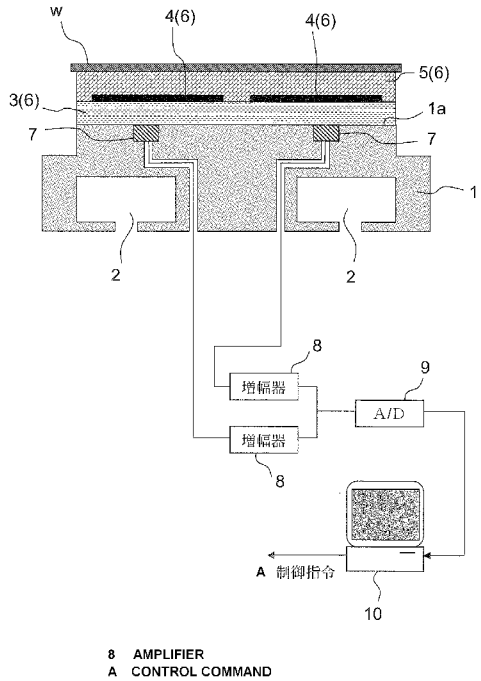
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) **Title**: ELECTROSTATIC CHUCK DEVICE AND METHOD FOR DETERMINING ADSORBED STATE OF WAFER

(54) 発明の名称 : 静電チャック装置及び基板の吸着状態判別方法

[図4]



8 AMPLIFIER
A CONTROL COMMAND

(57) **Abstract**: Provided is an electrostatic chuck device comprising adsorption determining means capable of quickly and accurately grasping the adsorbed state of a wafer. Furthermore, provided is a method for determining the adsorbed state of the wafer, whereby it is possible to quickly and accurately grasp the adsorbed state of the wafer in the electrostatic chuck device. The electrostatic chuck device in which an electrostatic chuck for adsorbing the wafer is provided on the upper surface side of a metal substrate is characterized in that the electrostatic chuck device comprises the adsorption determining means for determining the adsorbed state of the wafer. Furthermore, the method for determining the adsorbed state of the wafer in the electrostatic chuck device in which the electrostatic chuck for adsorbing the wafer is provided on the upper surface side of the metal substrate is characterized in that the flow of the heat from the wafer transferred via the electrostatic chuck is obtained by heat flux sensors to determine the absorbed state of the wafer.

(57) 要約: 基板の吸着状態を迅速かつ正確に把握することができる吸着判別手段を備えた静電チャック装置を提供し、また、静電チャック装置での基板の吸着状態を迅速かつ正確に把握することができる基板の吸着状態判別方法を提供する。 基板を吸着させる静電チャックを金属基盤の上面側に備えた静電チャック装置であり、基板の吸着状態を判別するための吸着判別手段を備えたことを特徴とする静電チャック装置であり、また、基板を吸着させる静電チャックを金属基盤の上面側に備えた静電チャック装置において、基板の吸着状態を判別する方法であって、静電チャックを介して伝達される基板からの熱の流れを熱流束センサで得て、基板の吸着状態を判別することを特徴とする基板の吸着状態判別方法である。

WO 2010/026893 A1

添付公開書類:

— 国際調査報告（条約第 21 条(3)）